



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115459624 A

(43) 申请公布日 2022. 12. 09

(21) 申请号 202111458068.0

(22) 申请日 2021.12.01

(30) 优先权数据

2021-096283 2021.06.09 JP

(71) 申请人 A·罗西

地址 意大利罗马

(72) 发明人 A·罗西

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有

限公司 44205

专利代理师 伍志健 林明校

(51) Int.Cl.

H02N 1/08 (2006.01)

H02J 7/32 (2006.01)

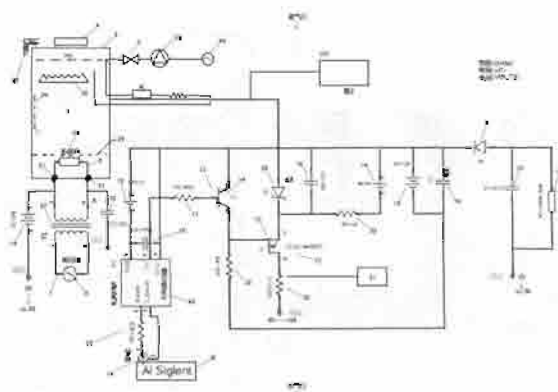
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

电能产生装置及电能产生方法

(57) 摘要

尽管因真空中的允许的能量状态的密度高而有利于虚粒子的生成,但在通常的金属导体中,由于允许状态的数量比较少而阻碍了虚粒子的生成。可以利用这种差异来制作高效的电能产生装置,而这正是本发明的目的。上述目的是通过一种电能产生装置解决的,该装置由包含导体的金属或石英形成,与驱动钨钨合金制的电子枪的电源连接而形成,且由在所述电子枪上设置栅极而成的导电性中空壳体形成,其中,电子击中相反侧的靶时,磁铁使所述电子向靶直线移动,所述壳体接地直到中空饱和,饱和时MOSFET阻碍所述电子向接地端移动,二极管将所述电子导向电容器,并从电容器导向负载。



1. 电能产生装置, 由包含导体的金属或石英形成, 与驱动钨钨合金制的电子枪的电源连接而形成, 且由在所述电子枪上设置栅极而成的导电性中空壳体形成, 其中,

电子击中相反侧的靶时, 磁铁使所述电子向靶直线移动, 所述壳体接地直到中空饱和, 饱和时MOSFET阻碍所述电子向接地端移动, 二极管将所述电子导向电容器, 并从电容器导向负载。

2. 根据权利要求1所述的电能产生装置, 所述MOSFET由配置于两个电阻之间的NPN晶体管操作, 并通过频率发生器供给电力。

3. 根据权利要求2所述的电能产生装置, 一个电阻被配置于DC能量源和所述NPN晶体管之间, 另一个电阻被配置于所述NPN晶体管和所述频率发生器的连接点之间。

4. 根据权利要求2或3所述的电能产生装置, DC电流源被配置于所述MOSFET和所述NPN晶体管之间。

5. 根据权利要求1至4中任一项所述的电能产生装置, 所述MOSFET产生使所述电子向接地端移动的相位和所述电子向所述负载移动的相位交替地重复所需的频率。

6. 根据权利要求1至5中任一项所述的电能产生装置, 真空泵通过阀使所述壳体内成为真空, 该真空中含有氩气或其他气体和金属, 所述壳体以一定的真空度被密闭。

7. 根据权利要求1至6中任一项所述的电能产生装置, 所述电子枪通过DC电源供给电力以获得比接地的线的电压更低的电压, 并通过DC电流源来供给电力。

8. 根据权利要求1至7中任一项所述的电能产生装置, 通过可变变压器调制流经所述电子枪和地线的DC电流。

9. 根据权利要求1至8中任一项所述的电能产生装置, 所述电子枪和所述壳体之间通过电绝缘材料进行电绝缘。

10. 根据权利要求1至9中任一项所述的电能产生装置, 所述壳体由热交换器制成双层壁, 以回收从所述电能产生装置散发的热量。

11. 根据权利要求1至10中任一项所述的电能产生装置, 所述电子枪由通过DC线接地的电源进行充电, 以相对于阴极与连接于所述壳体的所述栅极之间的电压, 使阴极与接地端之间的电位维持在较高电位。

12. 根据权利要求1至11中任一项所述的电能产生装置, 所述电容器具有所述MOSFET的击穿电压以下的电压, 和高于所述壳体及所述MOSFET的总电容的电容。

13. 根据权利要求1至12中任一项所述的电能产生装置, 所述MOSFET连接至配置于两个电阻之间的NPN晶体管, 以使来自频率发生器的信号被准确地维持在所述MOSFET必须发挥作用的值, 在所述NPN晶体管与所述频率发生器之间配置有一DC源, 所述MOSFET和所述接地端之间配置有另一DC电源。

14. 根据权利要求1至13中任一项所述的电能产生装置, 电阻将NPN晶体管极化, 电阻将齐纳二极管极化, 在NPN晶体管受到干扰时, 电阻使所述MOSFET的栅极相对于源极为+20V的电压, 电阻限制流向光电耦合器的LED的电流。

15. 根据权利要求1至14中任一项所述的电能产生装置, 电容器蓄积待发送至所述负载的电子, 电容器降低齐纳二极管的阻抗, 电容器用于24V电池的旁路, 电容器连接至光电耦合器, 电容器用于阴极的旁路。

16. 根据权利要求1至15中任一项所述的电能产生装置, 包括齐纳二极管, 所述齐纳二

极管用于在电压到达所述壳体与所述MOSFET之间时,使电流逆流。

17.根据权利要求16所述的电能产生装置,在电压达到时,二极管将电流导入电容器。

18.根据权利要求16所述的电能产生装置,光电耦合器将频率发生器与开关电路隔离。

19.根据权利要求16所述的电能产生装置,NPN晶体管处理流向SiC-MOSFET的电流。

20.根据权利要求16所述的电能产生装置,SiC-MOSFET调节过程的交替循环,以使电流可以流向接地端或流入所述外壳。

21.根据权利要求1至20中任一项所述的电能产生装置,等离子体由以层状被配置于反应器内壁、成分为: Au、Ga、In、P、Ge、As、Bi形成的合金包围。

22.根据权利要求1至21中任一项所述的电能产生装置,人工智能装置基于增加安培时功率按安培的平方成指数函数增加的事实,在时间上优化V、A、W之间的比率。

23.根据权利要求1至22中任一项所述的电能产生装置,等离子体反应器容纳于回收由等离子体生成的热能的热交换器的内部。

24.根据权利要求1至23中任一项所述的电能产生装置,利用由等离子体生成的负电阻,通过与电感和电容器串联配置的RLC电路获得振荡。

25.根据权利要求1至24中任一项所述的电能产生装置,人工智能系统通过利用增加安培数时电力成指数函数增加的方法来指示装置。

26.根据权利要求1至25中任一项所述的电能产生装置,可以与获得比现有任何种类的灯更高的照明效率的LED灯进行组合。

27.根据权利要求1至26中任一项所述的电能产生装置,能够使用装置内的残留光,并使用光纤以非常高的效率将其传输到需要的场所。

28.根据权利要求1至26中任一项所述的电能产生装置,可用于在电动汽车行驶中对电动汽车的电池进行充电,提高自主性,将发电产生的电力的电压调整为汽车电池模块的电压。

29.一种使用装置产生电能的方法,该装置由包含导体的金属或石英形成,与驱动钨钨合金制的电子枪的电源连接而形成,且由在所述电子枪上设置栅极而成的导电性中空壳体形成,所述方法的特征在于,

电子击中相反侧的靶时,磁铁使所述电子向靶直线移动,所述壳体接地直到中空饱和,饱和时MOSFET阻碍所述电子向接地端移动,二极管将所述电子导向电容器,并从电容器导向负载。

30.根据权利要求29所述方法,生成在空间电荷、真空极化、真空中加热的阴极周围形成电子云的虚粒子。

31.根据权利要求29至30中任一项的所述方法,从“零点能量”开始,以通过增强电子的颤动和阿哈拉诺夫-玻姆效应的 dV/dT 的比率来生成高的 dV ,改变电子的相位,以相位的相干性配置在簇中,产生更低的熵、更低的热容量及更少的自由度,将多余的能量传输至非相位相干电子,从而导致发射过剩的光子。

电能产生装置及电能产生方法

技术领域

[0001] 本发明来源于与空间电荷、真空极化和虚粒子的概念相联系的理论,涉及真空中加热的阴极的周围电子云的自发形成。

背景技术

[0002] 基于本发明基础的物理学理论于2019年1月由研究门(Researchgate)的发明人发表(www.researchgate.net/publication/330601653-E-Cat_SK_and_long_range_particle_interactions),通过熵泵实现。此处,根据海森堡不确定性原理所预见的零点能量,在 dV/dt 下 dV 增大时,电子的颤动(Zitterbewegung)活跃,产生阿哈拉诺夫-玻姆(Aharonov Bohm)效应,电子的相位发生变化,形成相位一致的电子簇,熵、热容量、自由度变小,能量向相位不一致的电子移动,能量增加。

[0003] 尽管真空管技术从初期开始就已广为人知和广泛应用,但由于考虑到稳定的空间电荷的形成可以通过电子间的库仑力来防止,因此空间电荷效应没有明确定义的理论。但是,作为海森堡不确定性原理预测的量子波动的结果,实验发现可以通过虚电荷对的产生-湮灭而产生的真空极化来屏蔽排斥力。

[0004] 这样的粒子-反粒子对的寿命与其质量-能量成反比,但在其短暂的存在期间可以作为电容器的固体电介质的电荷发挥作用,能够遮挡电场、降低在电容板上蓄积电荷所需要的电压。

[0005] 现有技术文献

[0006] 专利文献

[0007] 【专利文献1】美国专利第9115913号说明书

[0008] 【专利文献2】美国专利第6465965号说明书

[0009] 【专利文献3】美国专利第9502202号说明书

[0010] 【专利文献4】美国专利第5502354号说明书

[0011] 【专利文献5】美国专利第7379286号说明书

[0012] 【专利文献6】美国专利第9306527号说明书

[0013] 【专利文献7】美国专利第3670494号说明书

[0014] 非专利文献

[0015] 【非专利文献1】Aharonov Y.and Bohm D.Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory,Physical Review,115:485-491,1959

[0016] 【非专利文献2】Hestenes D.Zitterbewegung Modeling,Foundations of Physics,23 (3) :365-387,1993

[0017] 【非专利文献3】Dirac P.A.M.Nobel lecture,Theory of Electrons and Positrons,Nobel Lectures,Physics 1922-1941,1965

[0018] 【非专利文献4】Feynman R.P.QED:The Strange Theory of Light and Matter,Penguin Books,Penguin 1990

[0019] 【非专利文献5】Giorgio Vassallo et Al.:Maxwell-Dirac Theory and Occam's Razor:Unified Field,Elementary Particles,and Nuclear Interactions,Amazon 2019

[0020] 【非专利文献6】Andrea Rossi:Ecat SK and long range particle nteractions,[online],2019年1月,ResearchGate,[2021年6月8日检索],网址:

[0021] www.researchgate.net/publication/330601653_E-Cat_SK_and_long_range_particle_interactio_ns

发明内容

[0022] [发明要解决的问题]

[0023] 尽管因真空中的允许的能量状态的密度高而有利于上述虚粒子的生成,但在通常的金属导体中,由于允许状态的数量比较少而阻碍了上述虚粒子的生成。可以利用这种差异来制作高效的电能产生装置,而这正是本发明的目的。这种能量是通过由镓、铟、砷、磷、锗、金、铋的合金形成层状的中空固体中的壁,将得到光子的等离子体转换为电能而产生的。至今没有人成功实现基于空间电荷概念的电能产生装置并进行运用,本发明的装置首次应对了运用空间电荷的问题。

[0024] 本发明的装置与专利文献1~7中记载的现有的电、光、热的能量产生装置完全不同,如后述的实验表明的那样,获得了更高的效率。

[0025] [解决问题所采用的手段]

[0026] 根据本发明的各实施例,提供了以下内容:

[0027] [1]电能产生装置,由包含导体的金属或石英形成,与驱动钨钨合金制的电子枪的电源连接而形成,且由在所述电子枪上设置栅极(grid)而成的导电性中空壳体形成,其中,
[0028] 电子击中相反侧的靶时,磁铁使所述电子向靶直线移动,所述壳体接地直到中空饱和,饱和时MOSFET阻碍所述电子向接地端移动,二极管将所述电子导向电容器,并从电容器导向负载。

[0029] [2]根据[1]所述的电能产生装置,所述MOSFET由配置于两个电阻之间的NPN晶体管操作,并通过频率发生器供给电力。

[0030] [3]根据[2]所述的电能产生装置,一个电阻被配置于DC能量源和所述NPN晶体管之间,另一个电阻被配置于所述NPN晶体管和所述频率发生器的连接点之间。

[0031] [4]根据[2]或[3]所述的电能产生装置,DC电流源被配置于所述MOSFET和所述NPN晶体管之间。

[0032] [5]根据[1]至[4]中任一项所述的电能产生装置,所述MOSFET产生使所述电子向接地端移动的相位和所述电子向所述负载移动的相位交替地重复所需的频率。

[0033] [6]根据[1]至[5]中任一项所述的电能产生装置,真空泵通过阀使所述壳体内成为真空,该真空中含有氩气或其他气体和金属,所述壳体以一定的真空度被密闭。

[0034] [7]根据[1]至[6]中任一项所述的电能产生装置,所述电子枪通过DC电源供给电力以获得比接地的线的电压更低的电压,并通过DC电流源来供给电力。

[0035] [8]根据[1]至[7]中任一项所述的电能产生装置,通过可变变压器调制流经所述电子枪和地线的DC电流。

[0036] [9]根据[1]至[8]中任一项所述的电能产生装置,所述电子枪和所述壳体之间通

过电绝缘材料进行电绝缘。

[0037] [10]根据[1]至[9]中任一项所述的电能产生装置,所述壳体由热交换器制成双层壁,以回收从所述电能产生装置散发的热量。

[0038] [11]根据[10]所述电能产生装置,其中,所述热交换器使用气体或液体介质作为冷却剂。

[0039] [12]根据[1]至[11]中任一项所述的电能产生装置,所有的构成要素和所述电源通过同一的汇总总线接地。

[0040] [13]根据[1]至[12]中任一项所述的电能产生装置,所述电子枪由通过DC线接地的电源进行充电,以相对于阴极与连接于所述壳体的所述栅极之间的电压,使阴极与接地端之间的电位维持在较高电位。

[0041] [14]根据[1]至[13]中任一项所述的电能产生装置,所述电容器具有所述MOSFET的击穿电压以下的电压,和高于所述壳体及所述MOSFET的总电容的电容。

[0042] [15]根据[1]至[14]中任一项所述的电能产生装置,电压、安培数、静电电容、尺寸、特斯拉、材料的选择取决于该电能产生装置的输出。

[0043] [16]根据[1]至[15]中任一项所述的电能产生装置,所述MOSFET连接至配置于两个电阻之间的NPN晶体管,以使来自频率发生器的信号被准确地维持在所述MOSFET必须发挥作用的值,在所述NPN晶体管与所述频率发生器之间配置有一DC源,所述MOSFET和所述接地端之间配置有另一DC源。

[0044] [17]根据[1]至[16]中任一项所述的电能产生装置,所述MOSFET和所述NPN晶体管通过散热器和风扇进行冷却。

[0045] [18]根据[1]至[17]中任一项所述的电能产生装置,电阻将NPN晶体管极化,电阻将齐纳二极管极化,在NPN晶体管受到干扰时,电阻使所述MOSFET的栅极(gate)相对于源极为+20V的电压,电阻限制流向光电耦合器的LED的电流。

[0046] [19]根据[1]至[18]中任一项所述的电能产生装置,电容器蓄积待发送至所述负载的电子,电容器降低齐纳二极管的阻抗,电容器用于24V电池的旁路,电容器连接至光电耦合器,电容器用于阴极的旁路。

[0047] [20]根据[1]至[19]中任一项所述的电能产生装置,包括齐纳二极管,所述齐纳二极管用于在电压到达所述壳体与所述MOSFET之间时,使电流逆流。

[0048] [21]根据[20]所述的电能产生装置,在电压达到时,二极管将电流导入电容器。

[0049] [22]根据[20]所述的电能产生装置,光电耦合器将频率发生器与开关电路隔离。

[0050] [23]根据[20]所述的电能产生装置,NPN晶体管处理流向SiC-MOSFET的电流。

[0051] [24]根据[20]所述的电能产生装置,SiC-MOSFET调节过程的交替循环,以使电流可以流向接地端或流入所述外壳。

[0052] [25]根据[1]至[24]中任一项所述的电能产生装置,等离子体由以层状被配置于反应器内壁、成分为: Au、Ga、In、P、Ge、As、Bi形成的合金包围。

[0053] [26]根据[1]至[25]中任一项所述的电能产生装置,人工智能装置基于增加安培时功率按安培的平方成指数函数增加的事实,在时间上优化V、A、W之间的比率。

[0054] [27]根据[1]至[26]中任一项所述的电能产生装置,等离子体反应器容纳于回收由等离子体生成的热能的热交换器的内部。

[0055] [28]根据[1]至[27]中任一项所述的电能产生装置,利用由等离子体生成的负电阻,通过与电感和电容器串联配置的RLC电路获得振荡。

[0056] [29]根据[1]至[28]中任一项所述的电能产生装置,人工智能系统通过利用增加安培数时电力成指数函数增加的方法来指示装置。

[0057] [30]根据[1]至[29]中任一项所述的电能产生装置,可以与获得比现有任何种类的灯更高的照明效率的LED灯进行组合。

[0058] [31]根据[1]至[26]中任一项所述的电能产生装置,能够使用装置内的残留光,并使用光纤以非常高的效率将其传输到需要的场所。

[0059] [32]根据[1]至[31]中任一项所述的电能产生装置,可用于在电动汽车行驶中对电动汽车的电池进行充电,提高自主性,将发电产生的电力的电压调整为汽车电池模块的电压。

[0060] [33]一种使用装置产生电能的方法,该装置由包含导体的金属或石英形成,与驱动钨钨合金制的电子枪的电源连接而形成,且由在所述电子枪上设置栅极而成的导电性中空壳体形成,该方法包括:

[0061] 电子击中相反侧的靶时,磁铁使所述电子向靶直线移动,所述壳体接地直到中空饱和,饱和时MOSFET阻碍所述电子向接地端移动,二极管将所述电子导向电容器,并从电容器导向负载。

[0062] [34]根据[33]所述方法,生成在空间电荷、真空极化、真空中加热的阴极周围形成电子云的虚粒子。

[0063] [35]根据[33]至[34]中任一项的所述方法,从“零点能量”开始,以通过增强电子的颤动和阿哈拉诺夫-玻姆效应的 dV/dT 的比率来生成高的 dV ,改变电子的相位,以相位的相干性配置在簇中,产生更低的熵、更低的热容量及更少的自由度,将多余的能量传输至非相位相干电子,从而导致发射过剩的光子。

附图说明

[0064] 图1是示出本发明的一个实施方式的电路图。

[0065] 图2是示出本发明的一个实施方式的电路图。

具体实施方式

[0066] 本发明的装置根据以下理论产生电能。即,真空中的空间电荷通过物质和反物质的虚粒子的形成,在其寿命期间屏蔽电子间的排斥,与其质量-能量成反比,因此足以得到屏蔽效果,降低在电容板上蓄积电荷所需的电压,从而产生宏观的电压和能量。由于电子的气体作为通过海森堡不确定性原理预测的量子波动结果、是虚电荷对的产生-湮灭所产生的真空极化的长距离静电屏蔽生成的,所以电能产生于壳体的壁上。因此,根据海森堡不确定性原理所预见的零点能量, dV/dt 增大电子的颤动和阿哈拉诺夫-玻姆效应,电子的相位发生变化,形成相位一致的电子簇,熵、热容量、自由度变小,能量向相位不一致的电子移动,光子的发射增大。

[0067] 本发明的装置通过由导电性材料构成的壳体、或内部含有导电体的石英管形成,并没有特别限定,例如可以列举出:中空的圆筒、中空的正六面体、平行六面体、其他中空的

形态等。

[0068] 例如,在圆筒一端的上部具有磁铁,在阴极的相反侧配置有电子枪。阴极和阳极之间在真空气氛下存在氩气或氙气等气体及金属,维持着等离子体状态。另外,圆筒也可以由含有导电体的石英形成。

[0069] 电子枪的阴极设有栅极,为了避免电子的排斥,电子被保持于圆筒的中空,通过磁铁产生的磁场被直线地导向相反侧的一端。

[0070] 电子枪由通过DC线接地的电源充电,以使阴极与地之间的电位高于连接于导电性壳体的栅极与阴极之间的电位。

[0071] 电压没有特别限定,可以根据系统的电力用可变变压器调整。

[0072] MOSFET(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor;金属氧化物半导体场效应晶体管)在百万分之一秒至数百万分之一秒的时间内,阻碍电子在电路中朝向负载前进;且当电子填满圆筒的壳体后,MOSFET打开接地的电路,关闭通向负载的电路。

[0073] 通向负载的路径中存在有二极管,以仅使超过阈值电压的电子通过。接着,电子到达电容器,电容器向负载发射电子。第二个周期与第一个周期一样,发生在百万分之一秒和数百万分之一秒之间。

[0074] MOSFET由NPN晶体管控制,并由将频率控制于1-3MHz的频率发生器充电。NPN晶体管被配置于1000欧姆、1V的电阻和100欧姆、7V电阻之间。第一个电阻被配置于NPN晶体管和频率发生器之间,第二个电阻被配置于NPN晶体管和24V电池之间。NPN晶体管和MOSFET的另一端之间配置有4V电池。事实上,由于频率发生器无法提供正确具备MOSFET-开关所需特性的电流,因此,为了高压下正确控制MOSFET-开关,需要将频率发生器的信号进行放大的发射极共同连接NPN晶体管,为了正确动作,需要从完全导通时的20V到完全阻断时的-4V的电压变动。MOSFET-开关的输入阻抗为200pF,是几乎纯粹的电容性。

[0075] 为了限制NPN晶体管的基极电流,NPN晶体管的电路是由1000欧姆的电阻完成的。当频率发生器的信号约为10V时,当有约9.4mA的电流流过NPN晶体管的基极时,NPN晶体管导通(饱和状态),与MOSFET的栅极相连的集电极几乎接地;由于VCE(sat)在几十分钟内变为1V,因此,MOSFET被切断。当频率发生器的信号为0V或者-1至-2V时,NPN晶体管不导通,100Ω的电阻使得MOSFET的栅极迅速达到20V。

[0076] $\tau = R \times C$

[0077] 其中,R=100欧姆(Ω),C=200pF。

[0078] 电容器必须保持在与MOSFET击穿电压一样低的电压,且其电容必须大于导电性的外壳和MOSFET的总电容。

[0079] 在操作开始之前,除非外壳保持在密封于一定的真空程度下,否则将导电性的外壳的内部抽空至高真空。

[0080] 绝热的双层壁换热器回收系统散发的热量。这样的热交换器可以使用气体或液体介质作为冷却剂。

[0081] 当达到合适的真空度时,提高真空度,强制地注入氩气等气体,直到真空度达到预定的程度,此时就可以密封外壳。

[0082] 所有的电源和电能产生装置的系统的构成要素都连接至汇总接地。

[0083] Ga-In-P-As-Ge-Au-Bi合金沿着反应器内壁、在阴极和阳极之间产生的等离子体

周围被配置为层状。

[0084] 该电能产生装置的动作通过人工智能系统进行控制,安培、伏特、瓦特的比率基于欧姆方程,即功率在安培增加时二次方地增加。

[0085] $I = A^2 \times R$

[0086] 一个重要的应用示例是这种电能产生装置与LED灯的组合。在实验中,从栅极向电能产生装置供给的4瓦电能达到20万流明。从照明夺走了全世界产生的电能的58%这一事实来看,这也是非常重要的。

[0087] 另外,也可以将该电能产生装置用于电动汽车电池的充电。在电动汽车行驶中给电池供电,可以大大提高汽车的自主性。此时,使产生的电的电压与电池模块的电压(通常为3.7V)一致。

[0088] 在图1中示出了本发明的一个实施方式。其构成要素如下。

[0089] 1-具备阴极和阳极的由钨钼合金制成的真空腔室

[0090] 2-由导电性金属构成的壳体(在一定真空度下密封)

[0091] 3-真空泵阀

[0092] 4-磁铁

[0093] 5-电子枪和栅极之间的DC电源

[0094] 6-电子枪和接地端之间的DC电源($V_6 > V_5$)

[0095] 7-可变变压器(Variac:调压器)

[0096] 8-电源

[0097] 9-二极管

[0098] 10-电容器

[0099] 11-负荷

[0100] 12-MOSFET/开关

[0101] 13-散热器+风扇

[0102] 14-电池

[0103] 15-电池

[0104] 16-NPN晶体管

[0105] 17-电阻

[0106] 18-频率发生器的BNC连接器

[0107] 19-频率发生器

[0108] 20-接地母线

[0109] 21-绝缘体

[0110] 22-电阻

[0111] 23-真空泵

[0112] 24-AC电源插座

[0113] 25-栅极

[0114] 26-热交换器

[0115] 27-变压器

[0116] 28-齐纳二极管

[0117] 29-光电耦合器

[0118] 30-电子枪

[0119] 31-示波器

[0120] 32-菲涅耳透镜

[0121] 33-用镓、铟、磷、砷、锗、金、铋的合金形成层状的等离子体周围的围栏

[0122] 34-符号33所述的合金的层

[0123] 上述构成要素的值和特性可以根据系统的电力、壳体的导电性金属的种类、壳体内壁上的层的合金等适当变更,而不损害本发明的有效性。

[0124] [实施例]

[0125] 以与图1和图2所示的实施方式及本说明书中记载的相同的设定,进行了一系列的实验。

[0126] 结果发现,由于高真空导致的阻抗降低,以及随之产生的空间电荷,因此,能量有所增加。另外,测量来自电能产生装置的残留光时发现,该残留光适合通过光纤扩散至任何地方使用。

[0127] 该实验在位于佛罗里达州迈阿密海滩(美国)和罗马(意大利)的莱昂纳多公司的研究所进行。

[0128] 在图1和图2所示的实施方式中,除了附图中记载的数字之外,下面还将描述下述符号。

[0129] 关于图1

[0130] R1是1kW电阻负载。

[0131] R2极化NPN晶体管,820欧姆1/2W。

[0132] R3极化齐纳二极管Z1,4.7V,10W。

[0133] R4为100欧姆、7W,当T1被阻断时,使MOSFET的栅极相对于源极为+20V。

[0134] R5为820欧姆、1W,限制流经光电耦合器的内部LED的电流。

[0135] RTEST为1欧姆、1/2W,通过示波器来监测MOSFET的漏极电流。

[0136] 电容器都是陶瓷的:

[0137] C1为0.15nF 1700V的电容器。

[0138] C2为100nF 50V的电容器,用于降低齐纳二极管的动作阻抗、降低噪声。

[0139] C3为24V电池旁路使用的100nF电容器。

[0140] C4为100nF的电容器,具有光电耦合器所需的低电压。连接于光电耦合器的连接部4和6附近。

[0141] C5为50nF的电容器,具有用于阴极旁路的低电压。

[0142] Z1是一个齐纳二极管,当达到电压时,它允许电流反向流动。

[0143] D1是高压、高速二极管。

[0144] U1为用于隔离开关电路的Siglent的光电耦合器。

[0145] T1为NPN晶体管。

[0146] T2是SiC-MOSFET,是交替切换系统的两种模式的开关。

[0147] PH是半导体的芯片。

[0148] AI是平衡A/V比和功率的人工智能。

- [0149] HX是热交换器,用于回收等离子体照射的热量。
- [0150] L是Au、Ge、P、Ga、In、As、Bi的合金的层。
- [0151] 开关电路整体与汇总接地充分地绝缘。
- [0152] 电池上显示的连接部2为正极。
- [0153] 频率发生器(Siglent)被调整为:输出方波+5V HI 0V LOW、50%占空比,且频率为1至5MHz。
- [0154] 每个晶体管都与散热器充分地分离。
- [0155] 关于图2
- [0156] 图2中,阳极与电感连接,通过对阴极和阳极之间被释放的电子进行浓缩,利用等离子体的负电阻,通过一系列的电容器和电感在电路中产生RLC振动。
- [0157] 图1和图2所示电路图的构成要素,如果按照相同的原理进行动作,本领域技术人员可以适当地变更。

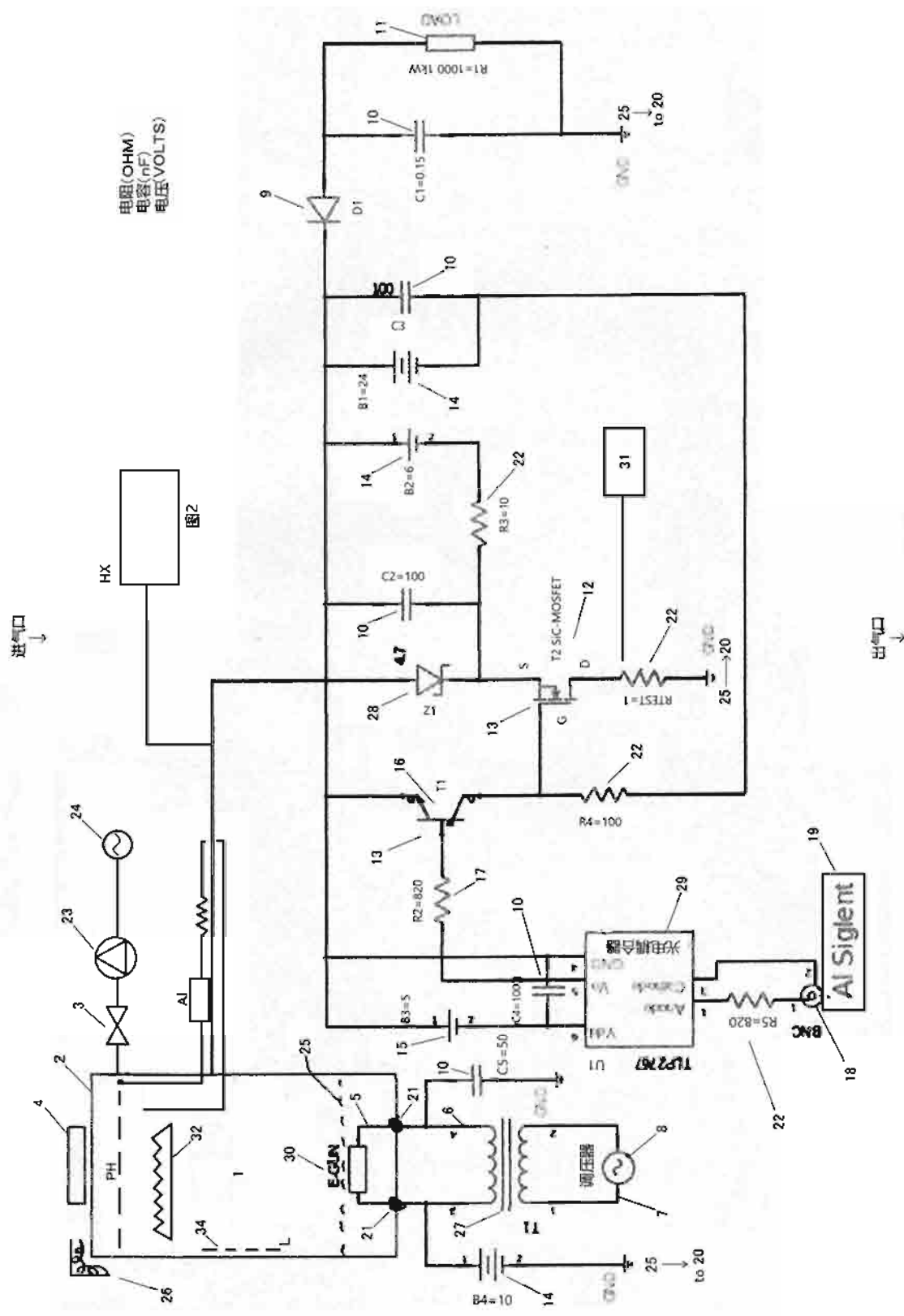


图 1

